

トランジスタ

2SA699, 2SA699A

2SA699, 2SA699A

シリコン PNP エピタキシャルプレーナ形 / Si PNP Epitaxial Planar

中電力増幅用 / Medium Power Amplifier

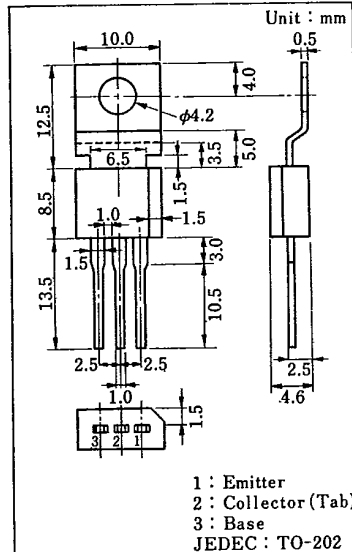
2SC1226, 2SC1226A とコンプリメンタリ / Complementary Pair
with 2SC1226, 2SC1226A

■ 特徴 / Feature

- 2SC1226, 2SC1226A とコンプリメンタリペアで出力 5W が得られます。 / 5W output in complementary pair with 2SC1226, 2SC1226A

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta=25 °C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	-V _{CB0}	40	V
2SA699A		50	
コレクタ・エミッタ電圧	-V _{CE0}	32	V
2SA699A		40	
エミッタ・ベース電圧	-V _{EBO}	5	V
せん頭コレクタ電流	-I _{CP}	3	A
ベース電流	-I _B	0.6	A
コレクタ損失 (T _c =25°C)	P _c	10	W
接合部温度	T _J	150	°C
保存温度	T _{stg}	-55~+150	°C



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics (Ta=25 °C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしゃ断電流	-I _{CB0}	-V _{CB} =20 V, I _E =0			1	μA
	-I _{CE0}	-V _{CE} =12 V, I _B =0			100	
エミッタしゃ断電流	-I _{EBO}	-V _{EB} =5 V, I _C =0			100	μA
コレクタ・ベース電圧	-V _{CB0}	-I _C =1 mA, I _E =0	40			V
			50			
コレクタ・エミッタ電圧	-V _{CE0}	-I _C =10 mA, I _B =0	32			V
			40			
直流電流増幅率	h _{FE} *	-V _{CE} =5 V, -I _C =1 A	50	120	220	
トランジション周波数	f _T	-V _{CE} =5 V, -I _C =0.5 A		150		MHz
ベース・エミッタ飽和電圧	-V _{BE(sat)}	-I _C =2 A, -I _B =0.2 A			1.5	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	-V _{CE(sat)}	-I _C =1.5 A, -I _B =0.15 A		0.4	1	V
コレクタ出力容量	C _{ob}	-V _{CB} =5 V, I _E =0, f=1 MHz		70		pF

* h_{FE} ランク分類 / h_{FE} Classifications

Class	P	Q	R
h _{FE}	50~100	80~160	100~220

トランジスタ

T-33-17

2SA699, 2SA699A

